

# SOT323 PNP SILICON PLANAR HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR

DRAFT SPECIFICATION ISSUE A – OCTOBER 94

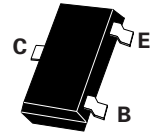
## ZUMT591

### FEATURES

- \* Extremely low saturation voltage
- \* 500mW power dissipation
- \* 1 Amp continuous collector current ( $I_C$ )

### APPLICATIONS

- \* Ideally suited for space / weight critical applications



SOT323

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-80	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-60	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-2	A
Continuous Collector Current	$I_C$	-1	A
Base Current	$I_B$	-200	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ ).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-80			V	$I_C=-100\mu\text{A}$ , $I_E=0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO(sus)}$	-60			V	$I_C=-10\text{mA}^*$ , $I_B=0$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$ , $I_C=0$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			-100	nA	$V_{CB}=-60\text{V}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CES}$			-100	nA	$V_{CE}=-60\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			-100	nA	$V_{EB}=-4\text{V}$ , $I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			-0.3 -0.6	V	$I_C=500\text{mA}$ , $I_B=50\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$ , $I_B=100\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			-1.2	V	$I_C=1\text{A}$ , $I_B=100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(on)}$			-1.0	V	$I_C=1\text{A}$ , $V_{CE}=-5\text{V}^*$

\* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle@2%

# ZUMT591

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	100 100 80 15		300		$I_C = -1\text{mA}, V_{CE} = -5\text{V}^*$ $I_C = -500\text{mA}, V_{CE} = -5\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}, V_{CE} = -5\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -5\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$	150			MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -10\text{V}^*$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$			10	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$

\* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle@2%

## NOTE

This data is derived from development material and does not necessarily mean that the device will go into production

## © Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telephone: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 <a href="mailto:europa.sales@zetex.com">europa.sales@zetex.com</a>	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 <a href="mailto:usa.sales@zetex.com">usa.sales@zetex.com</a>	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 <a href="mailto:asia.sales@zetex.com">asia.sales@zetex.com</a>	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 <a href="mailto:hq@zetex.com">hq@zetex.com</a>

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to [www.zetex.com](http://www.zetex.com)



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9